

Физика и техника полупроводников, 2025, том 59, выпуск 7

Международная конференция Физика А.СПб, 20-24 октября 2025 г., Санкт-Петербург

Агекян В.Ф., Вербин С.Ю., Серов А.Ю., Философов Н.Г., Штром И.В.

Исследование температурной зависимости вклада экситонов и свободных носителей в люминесценцию гетероструктуры CdTe/CdMgTe

379

Чистяков В.В., Рябцев С.В., Аль-Хабиб А.А.К., Соловьев С.М., Турищев С.Ю.

Хеометрический анализ функционирования тонких пленок PdO в качестве химического сенсора на озон в атмосфере воздуха

383

Федосов И.С., Фоминых Н.А., Крыжановская Н.В., Махов И.С., Минтаиров С.А., Калюжный Н.А., Солодовник М.С., Черненко Н.Е., Шандыба Н.А., Жуков А.Е.

Исследование излучения микродискового лазера, монолитно интегрированного с оптическим волноводом

388

Толкачев И.А., Юферев В.С.

Преобразование субнаносекундных лазерных импульсов в электрический ток многопереходными фотопреобразователями: роль туннельных диодов

392

Шабунина Е.И., Шмидт Н.М., Черняков А.Е., Тальнишних Н.А., Закгейм А.Л., Иванов А.Е., Алексанян Л.А., Поляков А.Я.

Снижение внешней квантовой эффективности ультрафиолетовых светодиодов, вызванное перелегированием барьеров кремнием

397

Лунин Л.С., Лунина М.Л., Донская А.В.

Фотоэлектрические преобразователи на основе гетероструктур $\text{Al}_{0.1}\text{Ga}_{0.2}\text{In}_{0.7}\text{Sb}_{0.2}\text{P}_{0.8}/\text{InP}$

402

Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Лобанов Д.Н., Калинин М.А., Кудрявцев К.Е., Андреев Б.А., Юнин П.А., Новиков А.В., Скороходов Е.В., Красильник З.Ф.

Формирование планарных структур с InGaN-слоями для источников света красного диапазона длин волн

406

Улин В.П., Ли Г.В., Нацкин А.В., Берковиц В.Л.

Золото на поверхности кристаллов Al_{III}Bv: эффекты каталитической диссоциации и анизотропного внедрения

414

Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Орлов В.Г., Сергеев Г.С., Иванов А.А.

Моделирование свойств MgAgSb --- перспективного термоэлектрического материала для использования в области температур 300-600 К

423

Физика полупроводниковых приборов

Жукавин Р.Х., Фадеев М.А., Антонов А.В., Постнов Д.А., Ковалевский К.А., Морозов С.В., Дубинов А.А., Афоненко А.А., Ушаков Д.В., Павлов А.Ю., Пономарев Д.С., Хабибуллин Р.А., Гавриленко В.И.

Терагерцовый квантовый каскадный лазер в квантующем магнитном поле

433

Папылев Д.С., Новиков И.И., Андрюшкин В.В., Гладышев А.Г., Дюделев В.В., Карачинский Л.Я., Бабичев А.В., Няпшаев И.А., Егоров А.Ю., Соколовский Г.С.

Влияние морфологии подложек InP на шероховатость интерфейсов и дефектность гетероструктур квантово-каскадных лазеров

439